

2DK120 型硅肖特基高速二极管

1 特性

芯片采用硅外延平面结构，器件有 D2-03A 型玻璃封装。

具有正向压降低、正向导通损耗小，体积小、重量轻，可靠性高的特点。

器件的静电放电敏感度为 4000V，D2-03A 典型重量 200mg。



D2-03A

2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611；

JCT 级：ZZR-Q/RBJ20044-2006。

3 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

| 型号 | I_{FM} mA | V_{RM} V | V_{RWM} V | I_{FSM} $t_p=8.3\text{ms}$, $T_A=25^{\circ}\text{C}$ mA | T_j $^{\circ}\text{C}$ | T_{stg} $^{\circ}\text{C}$ |
|--------|----------------|---------------|----------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| 2DK120 | 1000 | 30 | 24 | 6000 | -55~150 | -55~150 |

4 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

| 序号 | 符号 | 测试条件 | 规范值 |
|----|----------------|---|-----------------------|
| 1 | 正向压降 V_{FM1} | $I_F=1000\text{mA}$ | $\leq 0.60\text{V}$ |
| 2 | 正向压降 V_{FM2} | $T_A=-55^{\circ}\text{C}$, $I_F=1000\text{mA}$ | $\leq 1.8\text{V}$ |
| 3 | 反向电流 I_{R1} | $V_R=10\text{V}$ | $\leq 5\ \mu\text{A}$ |
| 4 | 反向电流 I_{R2} | $T_A=105^{\circ}\text{C}$, $V_R=10\text{V}$ | $\leq 2\text{mA}$ |

5 特性曲线

5.1 不同温度、不同电压下的反向电流曲线

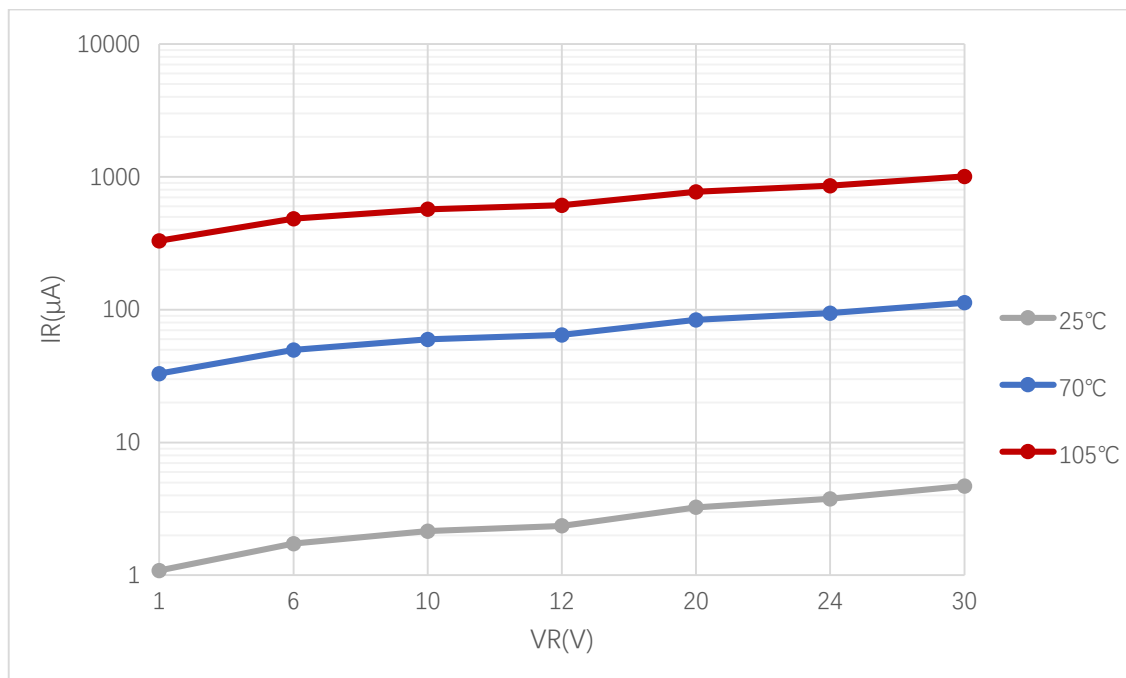


图1 I_R - V_R 特性曲线

5.2 不同温度、不同电流下的正向电压曲线

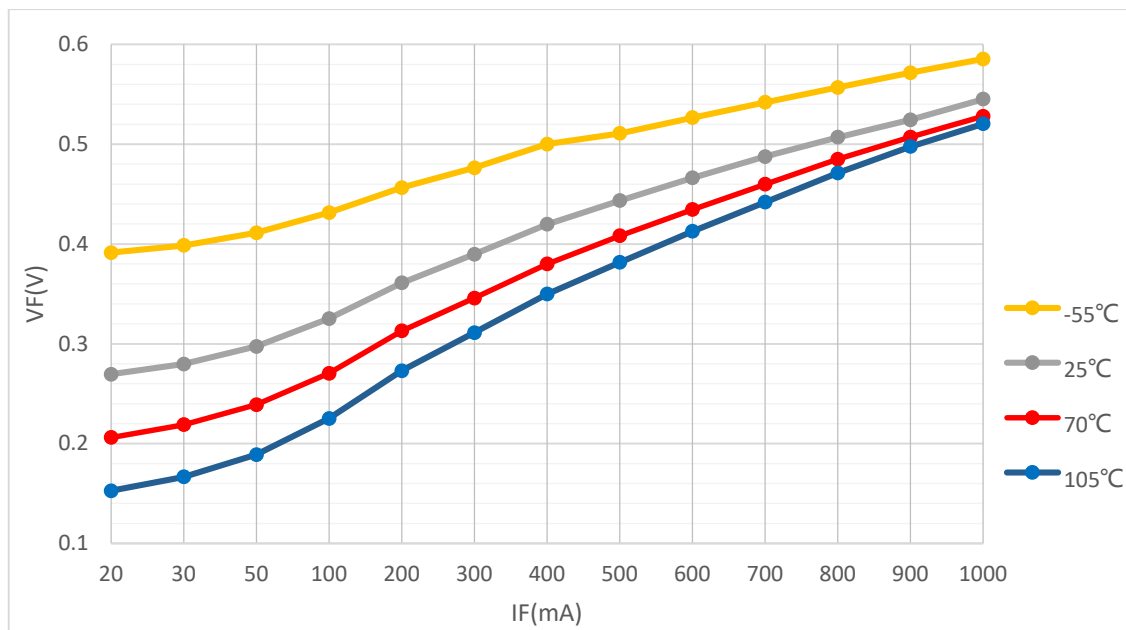
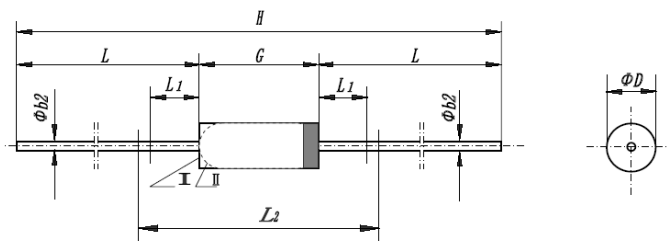


图2 V_F - I_F 特性曲线

6 外观尺寸

单位为毫米



- 注：① L_1 尺寸指在此段内引线直径不予限制，以允许引线涂料和表面少量的凹凸不平存在。
- ② L_2 为引线弯曲成直角后器件安装的最小轴向长度。
- ③ 主体形状允许采用两种形式，见图中轮廓线 I、II。

| 代号 | D2-03A | |
|-----------|--------|-------|
| 符号 | 最小值 | 最大值 |
| $\Phi b2$ | 0.458 | 0.558 |
| ΦD | 2.16 | 2.71 |
| G | 5.85 | 7.62 |
| H | 58 | — |
| L | 26 | — |
| $L1$ | — | 2.5 |
| $L2$ | 16 | — |

图 3 D2-03A 外形尺寸